

KPDE086S-H54P

规格

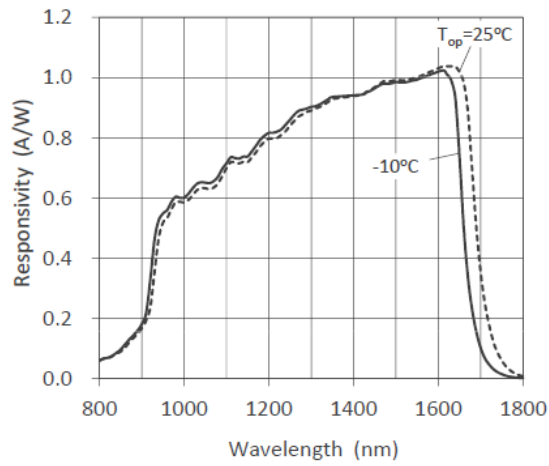
最大额定值

项目	符号	额定值	单位	备考
反向电压	V_R	20	V	
最大光输入功率	P_{imax}	50	mW	
正向电流	I_F	50	mA	
热敏电阻容许损耗	P_{th}	1.5	mW	
半导体制冷器电流	I_C	1.0(max)	A	
工作温度	T_{opr}	-40 to +70	°C	Avoid dew condensation
存储温度	T_{stg}	-40 to +85	°C	Avoid dew condensation

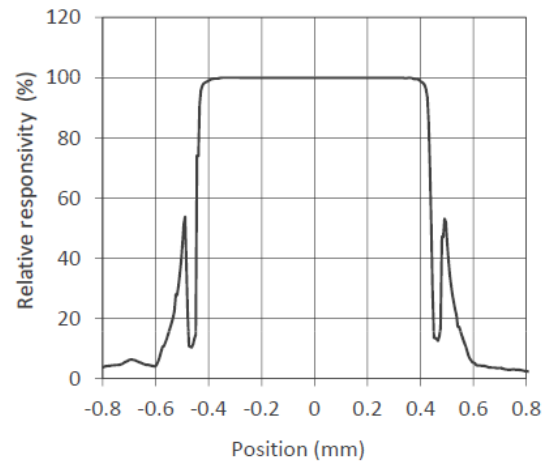
电子和光学特性

项目	符号	特征值			单位	条件
		最小	Typ.	最大		
光接收尺寸	S		0.86x0.86		mm ²	
检测波长	λ		1600(λ_p)		nm	λ_p =Peak wavelength
响应率	R	0.8 0.9	0.9 1.0		A/W	λ =1310nm λ =1550nm
暗电流	I_D		1	10	nA	V_R =5V
端子间电容	C_t		45	60	pF	f=1MHz

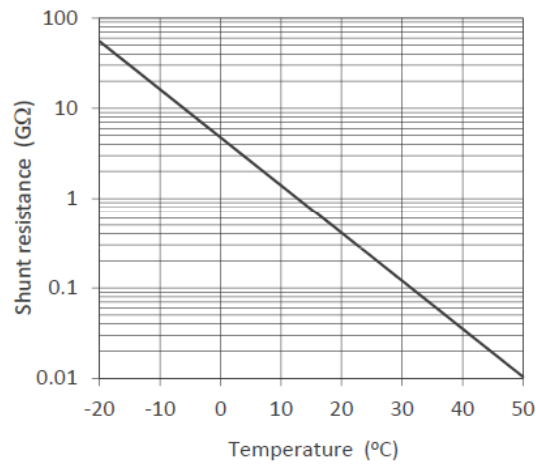
Spectral Responsivity



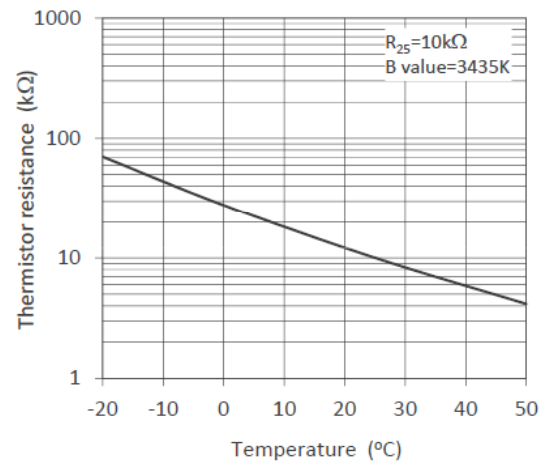
Responsivity Distribution



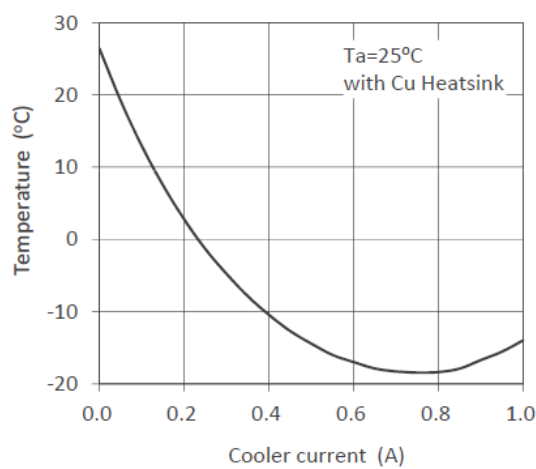
Shunt Resistance - Temperature



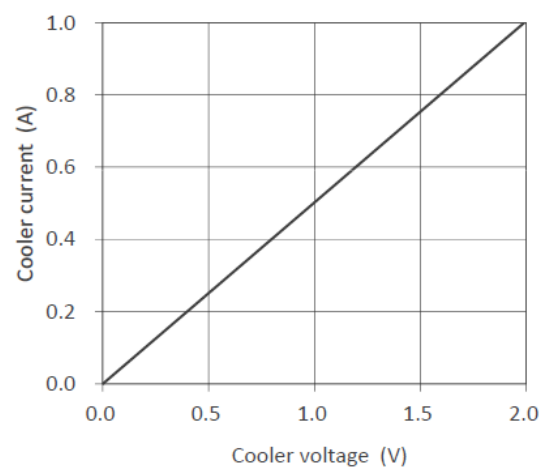
Thermistor Resistance - Temperature



TEC Temperature - Current



TEC Current - Voltage



特点

- 光接收面积大： 860 μm sq.
- 低暗电流、高分流电阻
- 配备电子制冷片和热敏电阻

应用

- 近红外传感器
- 近红外光谱分析
- 光功率测量仪

